

КРЕМНИЕВЫЙ ТРАНЗИСТОР
п-р-п

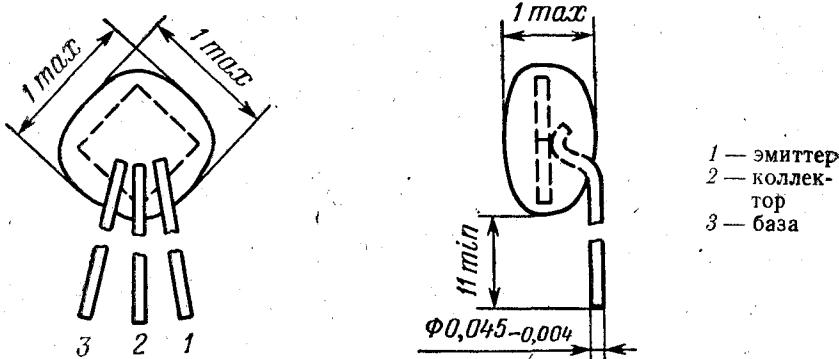
2Т318А-1

По техническим условиям ЩИЗ.365.002 ТУ

**Основное назначение — работа в аппаратуре специального назначения.
Оформление — бескорпусное.**

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Наибольшая высота (без выводов)	1 мм
Наибольшая ширина	1 мм
Вес наибольший	0,01 г



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Обратный ток коллектора при $U_{КБ} = 10$ В:

при $t_{окр} = 25 \pm 10^\circ\text{C}$	не более 0,5 мкА
» $t_{окр} = 85 \pm 3^\circ\text{C}$	не более 10 мкА

Обратный ток эмиттера при $U_{ЭБ} = 3$ В

не более 1 мкА

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером*:

при $t_{окр} = 25 \pm 10^\circ\text{C}$	30—90
» $t_{окр} = 85 \pm 3^\circ\text{C}$	25—180
» $t_{окр} = -60 \pm 3^\circ\text{C}$	15—90

Модуль коэффициента передачи тока при $f = 100$ МГц \circ

не менее 4,3

Напряжение насыщения коллектор—эмиттер \square :

при $t_{окр} = 25 \pm 10^\circ\text{C}$	не более 0,27 В
» $t_{окр} = 85 \pm 3^\circ\text{C}$	не более 0,3 В

Напряжение насыщения база—эмиттер \square :

- при $t_{окр} = 25 \pm 10^\circ \text{C}$
 » $t_{окр} = -60 \pm 3^\circ \text{C}$

не более 0,9 В
не более 1,05 В

Напряжение отпирания база—эмиттер Δ :

- при $t_{окр} = 25 \pm 10^\circ \text{C}$
 » $t_{окр} = 85 \pm 3^\circ \text{C}$

не более 0,57 В
не более 0,42 В

Емкость перехода при $f = 10 \text{ МГц}$:

- эмиттерного при $U_{ЭБ} = 0$
коллекторного при $U_{КБ} = 5 \text{ В}$

не более 4 пФ
не более 3,5 пФ

Время рассасывания \square :

не более 15 нс
не менее 15 000 ч

Долговечность

* При $U_{КБ} = 1 \text{ В}$ и $I_{\Theta} = 10 \text{ мА}$.○ При $U_{КБ} = 2 \text{ В}$ и $I_{\Theta} = 5 \text{ мА}$.□ При $I_K = 10 \text{ мА}$ и $I_B = 1 \text{ мА}$.△ При $U_{КБ} = 2,5 \text{ В}$ и $I_{\Theta} = 0,05 \text{ мА}$.

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ*

Наибольшее напряжение:

- коллектор—база, коллектор—эмиттер \circ
эмиттер—база

10 В

3,5 В

Наибольший ток коллектора:

- постоянный в режиме насыщения
импульсный Δ

20 мА

45 мА

Наибольшая рассеиваемая мощность:

- при $t_{окр} = -60 \div 55^\circ \text{C}$
 » $t_{окр} = 85^\circ \text{C}$

15 мВт

5 мВт

Наибольшее тепловое сопротивление переход-среда

3° С/мВт

Наибольшая температура перехода

100° С

* При $t_{окр} = -60 \div 85^\circ \text{C}$.○ При $R_{ЭБ} = 3 \text{ кОм}$.△ При $\tau_n < 10 \text{ мкс}$, $Q > 10$ и $\tau_\phi < 100 \text{ нс}$.□ При $t_{окр} = 55 \div 85^\circ \text{C}$ наибольшая мощность рассчитывается по формуле.

$$P_{K \max} = \frac{100 - t_{окр}}{3}, \text{ мВт.}$$

УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОТИВ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Температура окружающей среды:

- наибольшая
наименьшая

плюс 85° С

минус 60° С

КРЕМНИЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ

п—р—п

2T318A-1 2T318B-1 2T318B-1 2T318B1-1

Наибольшее ускорение:

при вибрации *	40	g
линейное	500	g
при многократных ударах	150	g
при одиночных ударах	1000	g

* В диапазоне частот 1—5000 Гц.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Допускается пайка (сварка) выводов на расстоянии не менее 1 мм от защитного покрытия.

При монтаже транзистора в микросхему не допускается соприкосновение выводов между собой и с кристаллом.

При пайке выводов должны быть приняты меры, исключающие нагрев кристалла свыше 100° С.

Гарантийный срок хранения 15 лет

2T318B-1

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером:

при $t_{окр} = 25 \pm 10^{\circ}$ С	50—150
» $t_{окр} = 85 \pm 3^{\circ}$ С	45—300
» $t_{окр} = -60 \pm 3^{\circ}$ С	26—150

Примечание. Остальные данные такие же, как у 2T318A-1.

2T318B-1

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером:

при $t_{окр} = 25 \pm 10^{\circ}$ С	70—280
» $t_{окр} = 85 \pm 3^{\circ}$ С	60—560
» $t_{окр} = -60 \pm 3^{\circ}$ С	33—280

Примечание. Остальные данные такие же, как у 2T318A-1.

2T318B1-1

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером:

при $t_{окр} = 25 \pm 10^{\circ}$ С	70—280
» $t_{окр} = 85 \pm 3^{\circ}$ С	60—560

2T318B1-1
2T318Г-1
2T318Д-1

КРЕМНИЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ

n-p-n

» $t_{окр} = -60 \pm 3^\circ \text{ С}$
Время рассасывания не более 10 нс

Примечание. Остальные данные такие же, как у 2T318A-1.

2T318Г-1

Модуль коэффициента передачи тока при $f = 100 \text{ МГц}$

не менее 3,5

Напряжение насыщения коллектор—эмиттер:

при $t_{окр} = 25 \pm 10^\circ \text{ С}$

не более 0,33 В

» $t_{окр} = 85 \pm 3^\circ \text{ С}$

не более 0,37 В

Напряжение насыщения база—эмиттер:

при $t_{окр} = 25 \pm 10^\circ \text{ С}$

не более 1 В

» $t_{окр} = -60 \pm 3^\circ \text{ С}$

не более 1,15 В

Напряжение отпирания база—эмиттер:

при $t_{окр} = 25 \pm 10^\circ \text{ С}$

не менее 0,55 В

» $t_{окр} = 85 \pm 3^\circ \text{ С}$

не менее 0,4 В

Емкость перехода при $f = 10 \text{ МГц}$:

эмиттерного при $U_{ЭБ} = 0$

не более 5 пФ

коллекторного при $U_{КБ} = 5 \text{ В}$

не более 4,5 пФ

Время рассасывания

не более 25 нс

Примечание. Остальные данные такие же, как у 2T318A-1.

2T318Д-1

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером:

при $t_{окр} = 25 \pm 10^\circ \text{ С}$

50—150

» $t_{окр} = 85 \pm 3^\circ \text{ С}$

45—300

» $t_{окр} = -60 \pm 3^\circ \text{ С}$

26—150

Модуль коэффициента передачи тока при $f = 100 \text{ МГц}$

не менее 3,5

Напряжение насыщения коллектор—эмиттер:

при $t_{окр} = 25 \pm 10^\circ \text{ С}$

не более 0,33 В

» $t_{окр} = 85 \pm 3^\circ \text{ С}$

не более 0,37 В

Напряжение насыщения база—эмиттер:

при $t_{окр} = 25 \pm 10^\circ \text{ С}$

не более 1 В

» $t_{окр} = -60 \pm 3^\circ \text{ С}$

не более 1,15 В

Напряжение отпирания база—эмиттер:

при $t_{окр} = 25 \pm 10^\circ \text{ С}$

не менее 0,55 В

» $t_{окр} = 85 \pm 3^\circ \text{ С}$

не менее 0,4 В

КРЕМНИЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ

п—р—п

2T318Д-1

2T318Е-1

Емкость перехода при $f=10$ МГц:

эмиттерного при $U_{\text{ЭБ}}=0$

не более 5 пФ

коллекторного при $U_{\text{КБ}}=5$ В

не более 4,5 пФ

Время рассасывания

не более 25 нс

Примечание. Остальные данные такие же, как у 2T318А-1.

2T318Е-1

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером:

при $t_{\text{окр}}=25 \pm 10^\circ \text{C}$ 70—280

» $t_{\text{окр}}=85 \pm 3^\circ \text{C}$ 60—560

» $t_{\text{окр}}=-60 \pm 3^\circ \text{C}$ 33—280

Модуль коэффициента передачи тока при $f=100$ МГц

не менее 3,6

Напряжение насыщения коллектор—эмиттер:

при $t_{\text{окр}}=25 \pm 10^\circ \text{C}$ не более 0,33 В

» $t_{\text{окр}}=85 \pm 3^\circ \text{C}$ не более 0,37 В

Напряжение насыщения база—эмиттер:

при $t_{\text{окр}}=25 \pm 10^\circ \text{C}$ не более 1 В

» $t_{\text{окр}}=-60 \pm 3^\circ \text{C}$ не более 1,15 В

Напряжение отпирания база—эмиттер:

при $t_{\text{окр}}=25 \pm 10^\circ \text{C}$ не менее 0,55 В

» $t_{\text{окр}}=85 \pm 3^\circ \text{C}$ не менее 0,4 В

Емкость перехода при $f=10$ МГц:

эмиттерного при $U_{\text{ЭБ}}=0$ не более 5 пФ

коллекторного при $U_{\text{КБ}}=5$ В не более 4,5 пФ

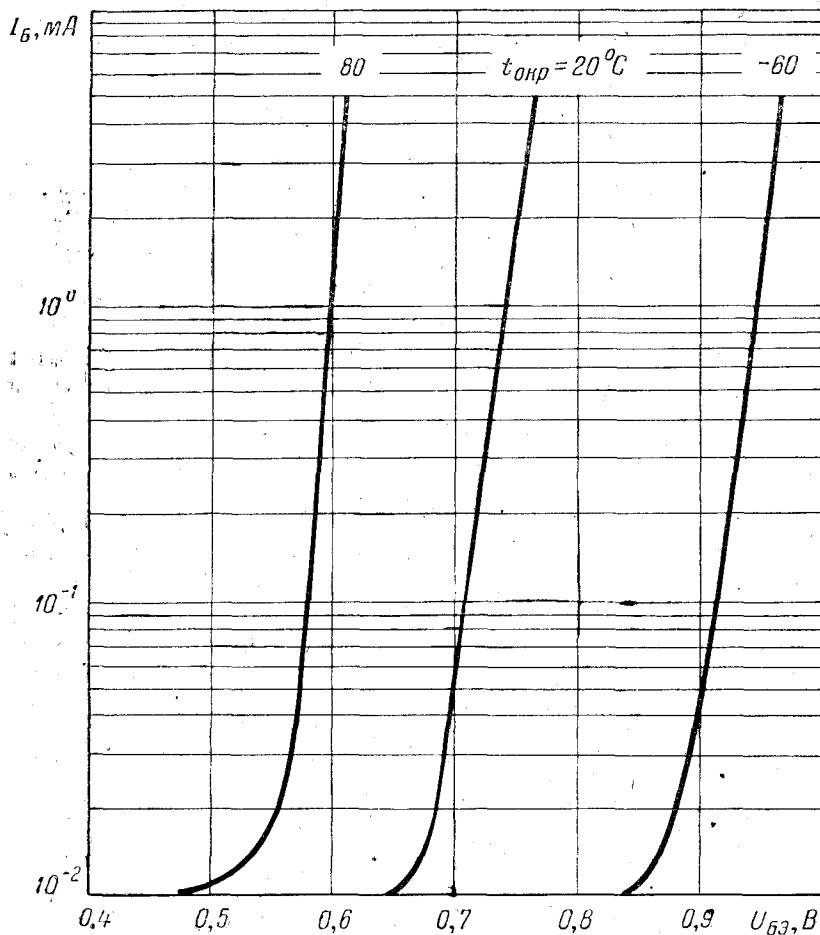
Время рассасывания не более 25 нс

Примечание. Остальные данные такие же, как у 2T318А-1.

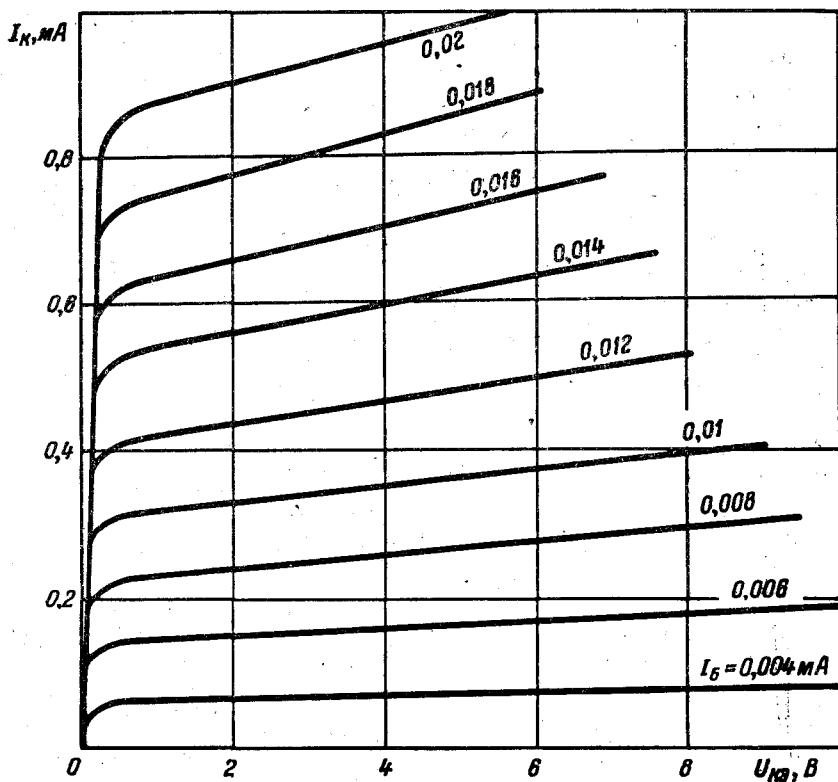
2T318A-1÷2T318E-1

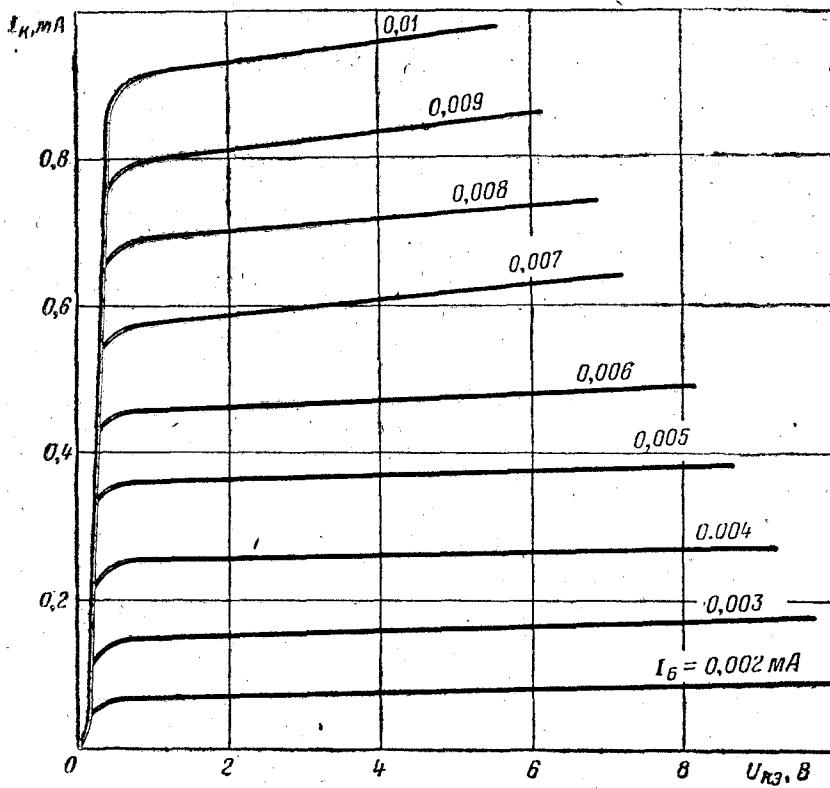
КРЕМНИЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ
n-p-n

ВХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(в схеме с общим эмиттером)



ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(в схеме с общим эмиттером).



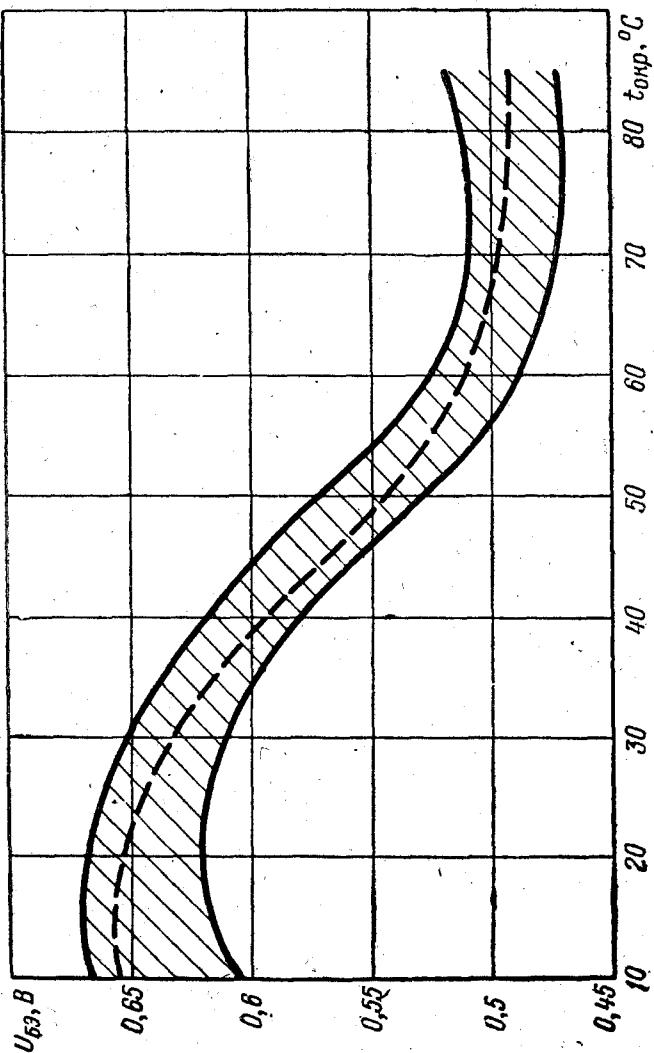
ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(в схеме с общим эмиттером)

КРЕМНИЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ

n-p-n

2T318A-1÷2T318B1-1

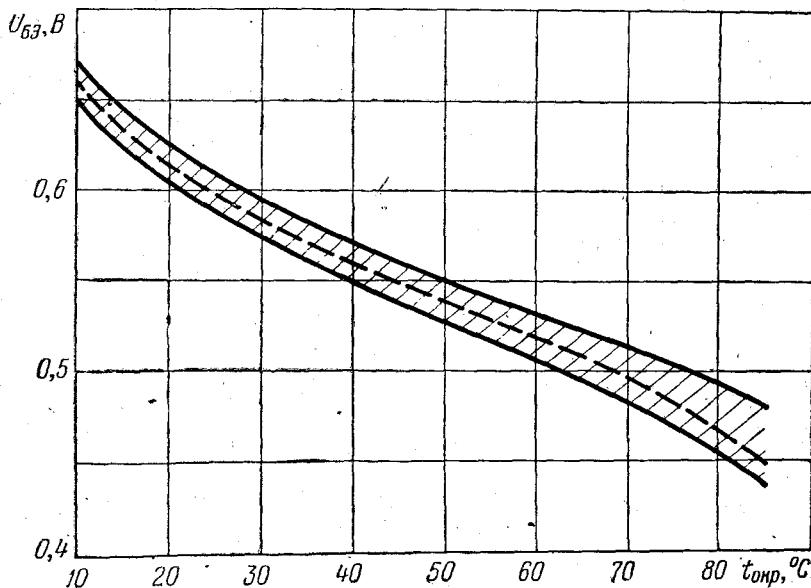
ОБЛАСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ОТПИРАНИЯ
БАЗА—ЭМИТЕР
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
(границы 95% разброса)



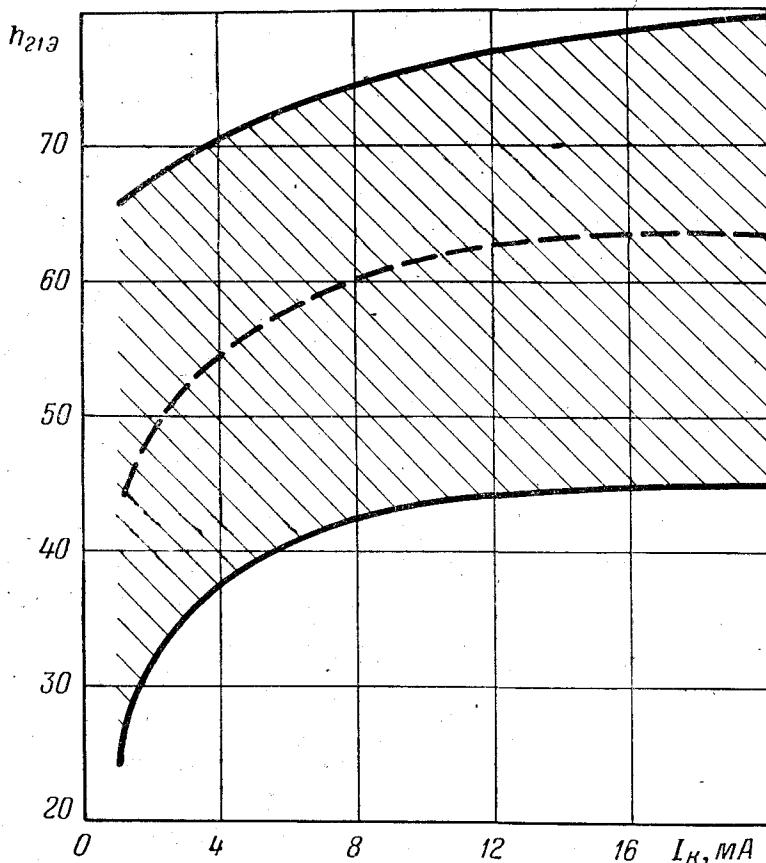
2Т318Г-1
2Т318Д-1
2Т318Е-1

КРЕМНИЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ
n-p-n

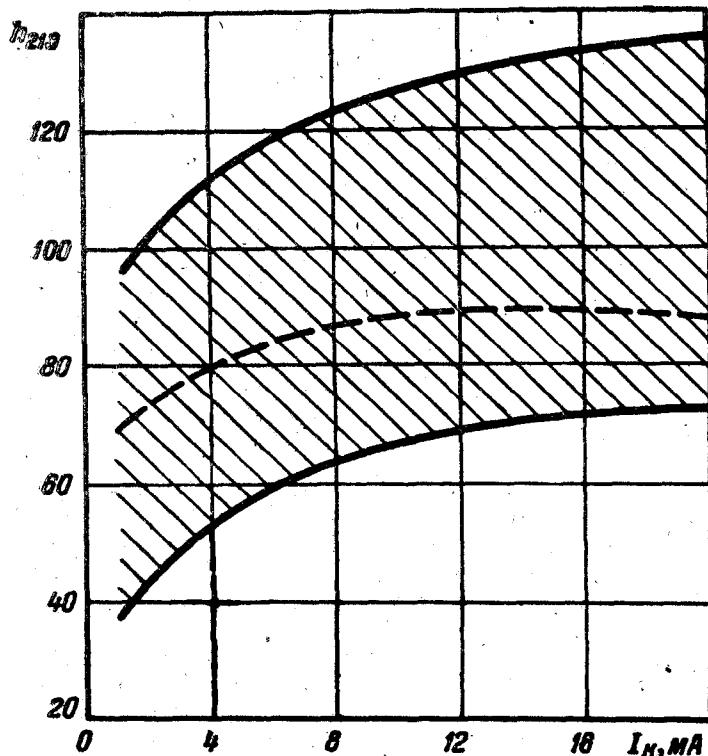
ОБЛАСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ОТПИРАНИЯ
БАЗА—ЭМИТЕР
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
(границы 95% разброса)



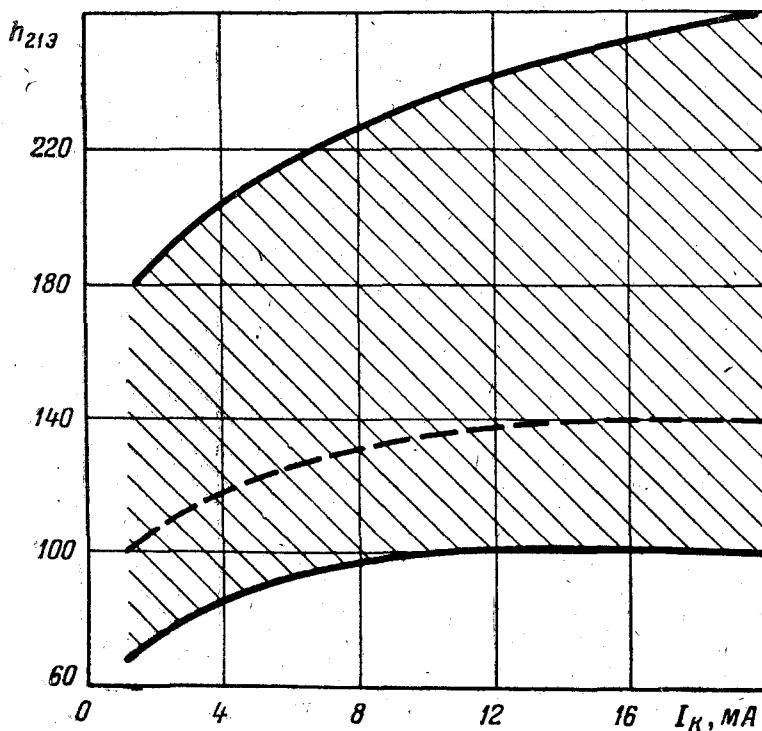
ОБЛАСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ СТАТИЧЕСКОГО КОЭФФИЦИЕНТА
ПЕРЕДАЧИ ТОКА В СХЕМЕ С ОБЩИМ ЭМИТТЕРОМ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОКА КОЛЛЕКТОРА
(границы 95% разброса)



ОБЛАСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ СТАТИЧЕСКОГО КОЭФФИЦИЕНТА
ПЕРЕДАЧИ ТОКА В СХЕМЕ С ОБЩИМ ЭМИТТЕРОМ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОКА КОЛЛЕКТОРА
(границы 95% разброса)

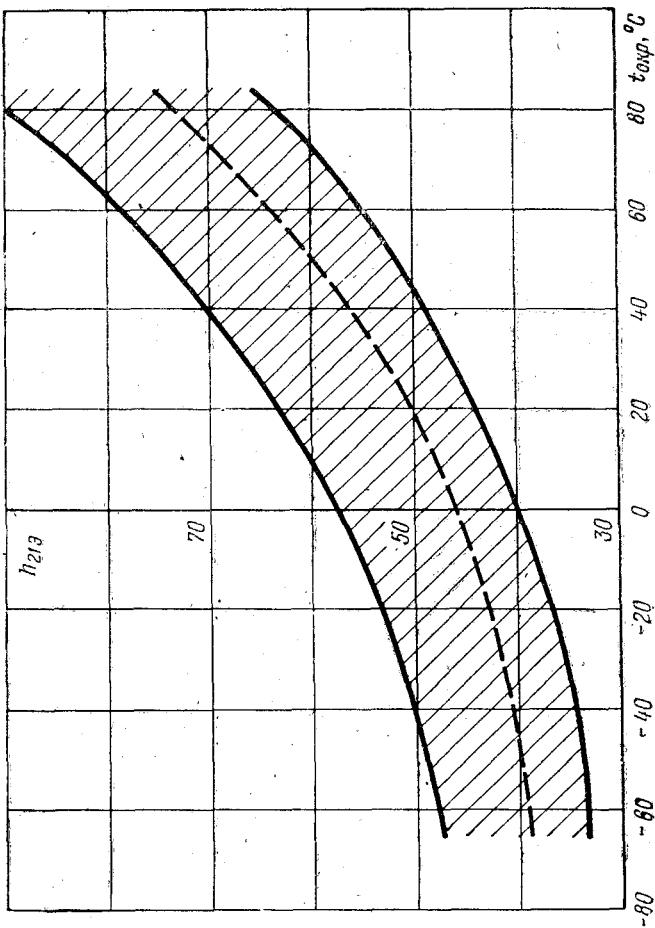


ОБЛАСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ СТАТИЧЕСКОГО КОЭФФИЦИЕНТА
ПЕРЕДАЧИ ТОКА В СХЕМЕ С ОБЩИМ ЭМИТЕРОМ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОКА КОЛЛЕКТОРА
(границы 95% разброса)



ОБЛАСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ СТАТИЧЕСКОГО КОЭФФИЦИЕНТА
ПЕРЕДАЧИ ТОКА В СХЕМЕ С ОБЩИМ ЭМИТТЕРОМ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
(границы 95% разброса)

При $U_{KB} = 1$ В, $I_E = 10$ мА

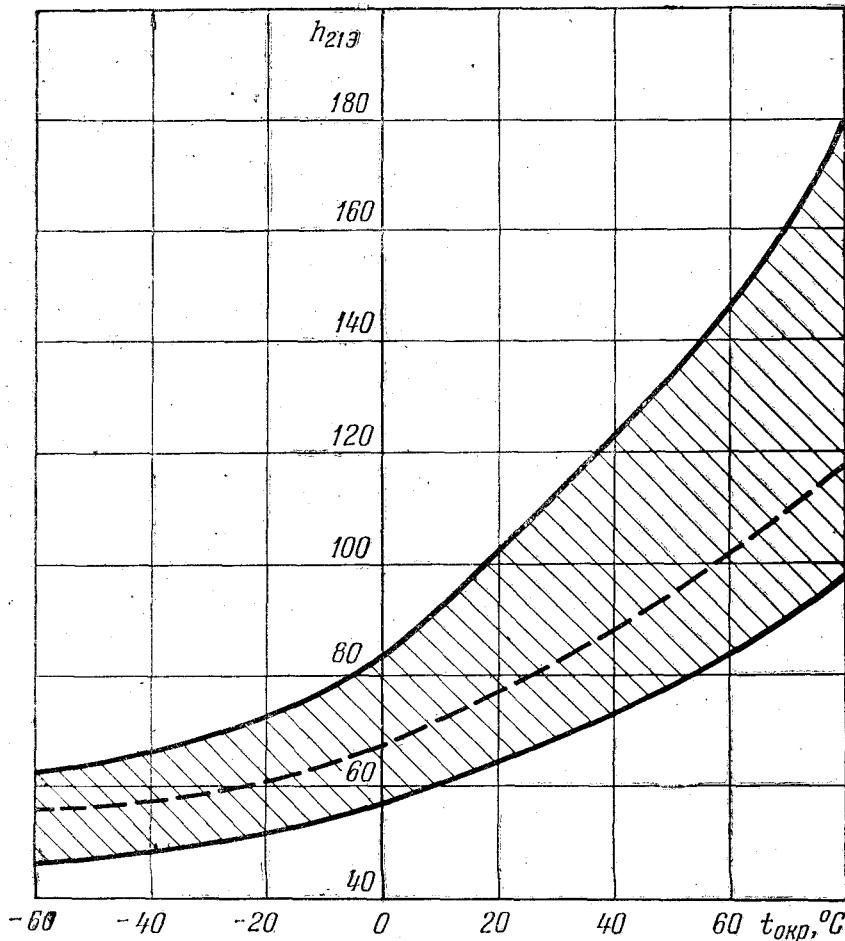


КРЕМНИЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ
п-р-п

2Т318Б-1
2Т318Д-1

ОБЛАСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ СТАТИЧЕСКОГО КОЭФФИЦИЕНТА
ПЕРЕДАЧИ ТОКА В СХЕМЕ С ОБЩИМ ЭМИТЕРРОМ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
(границы 95% разброса)

При $U_{KB} = 1$ В, $I_3 = 10$ мА

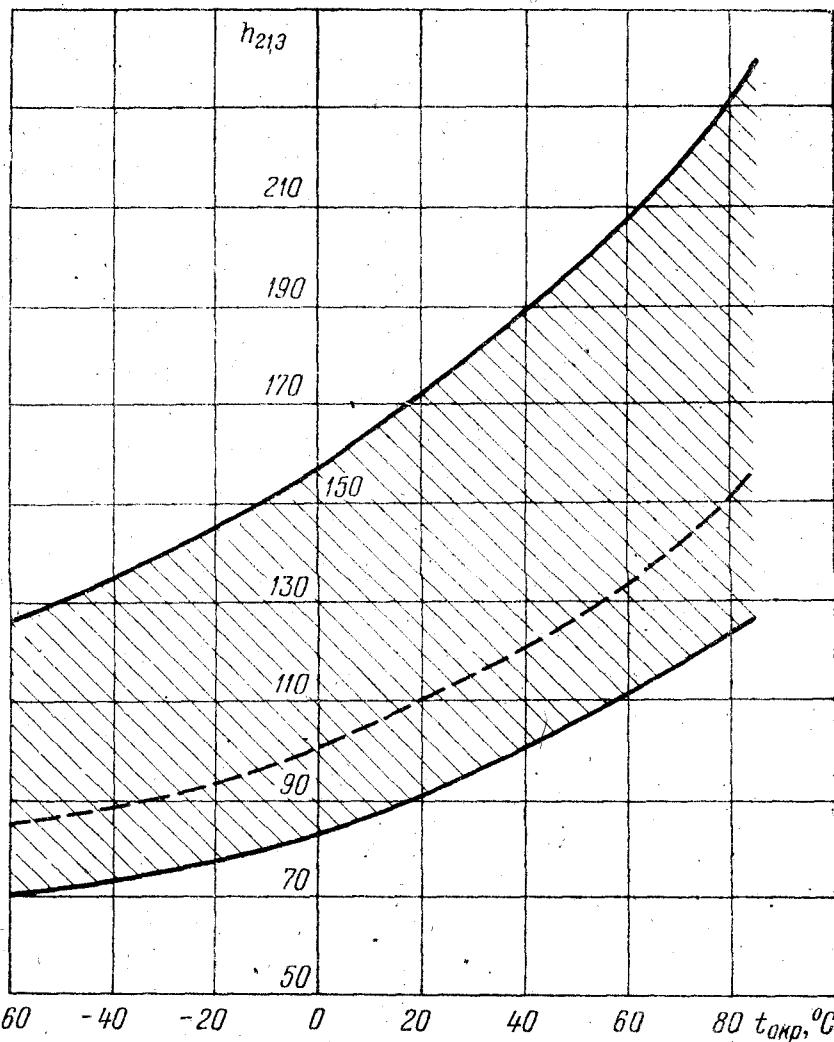


2T318B-1
2T318B1-1
2T318E-1

КРЕМНИЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ
n-p-n

ОБЛАСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ СТАТИЧЕСКОГО КОЭФФИЦИЕНТА
ПЕРЕДАЧИ ТОКА В СХЕМЕ С ОБЩИМ ЭМИТТЕРОМ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
(границы 95% разброса)

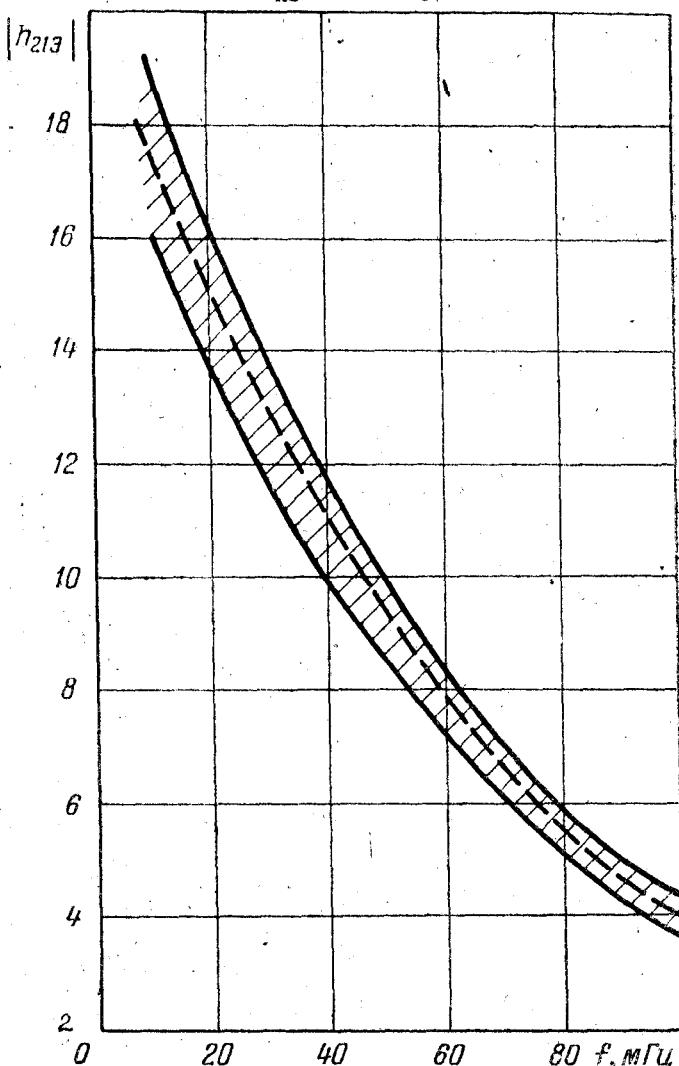
При $U_{KB} = 2$ В, $I_E = 5$ мА



КРЕМНИЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ
n-p-n

2T318A-1
2T318B-1
2T318B-1
2T318B1-1

ОБЛАСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ МОДУЛЯ КОЭФФИЦИЕНТА ПЕРЕДАЧИ ТОКА
В СХЕМЕ С ОБЩИМ ЭМИТТЕРОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЧАСТОТЫ
(границы 95% разброса)
При $U_{\text{КЭ}}=2$ В и $I_{\text{Э}}=5$ мА

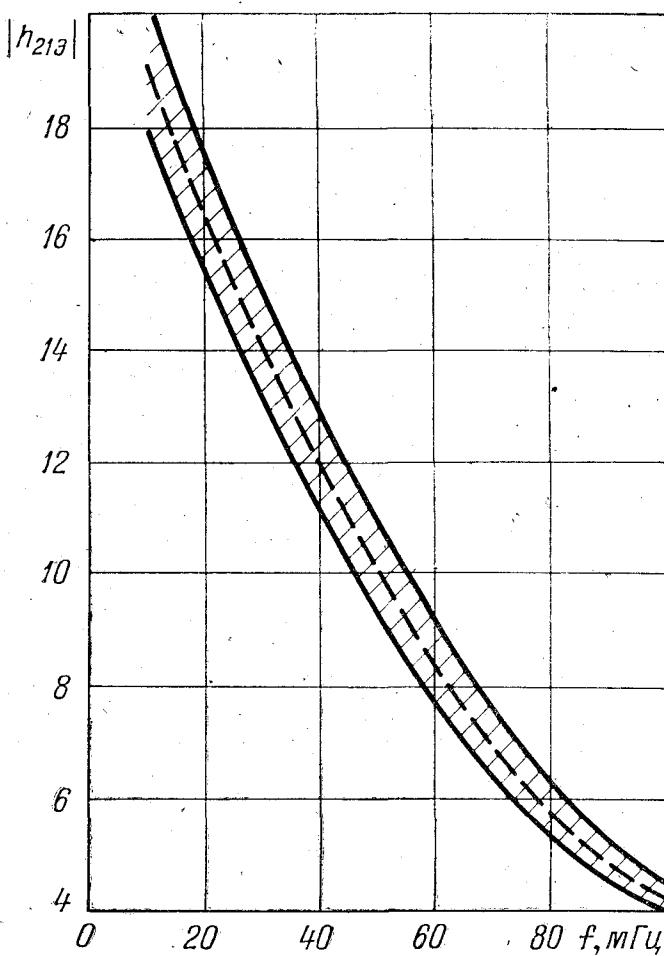


2Т318Г-1
2Т318Д-1
2Т318Е-1

КРЕМНИЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ
п-р-п

ОБЛАСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ МОДУЛЯ КОЭФФИЦИЕНТА ПЕРЕДАЧИ ТОКА
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЧАСТОТЫ
(границы 95% разброса)

При $U_{KB} = 2$ В, $I_E = 5$ мА

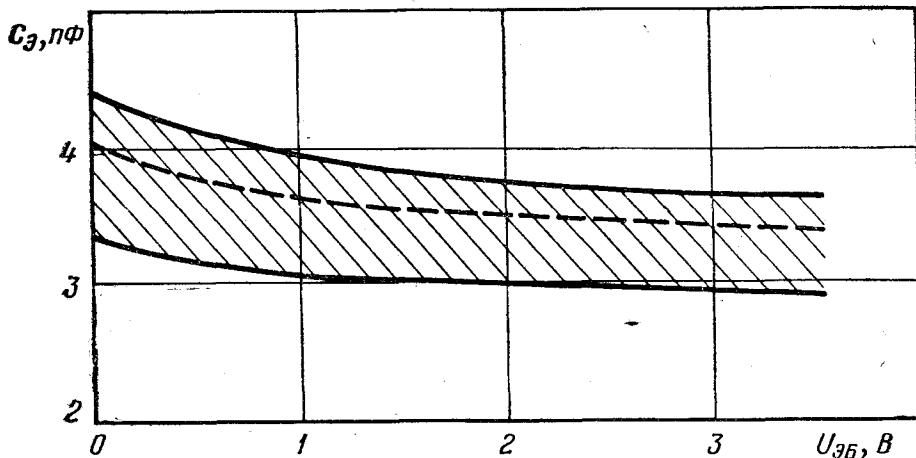


КРЕМНИЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ

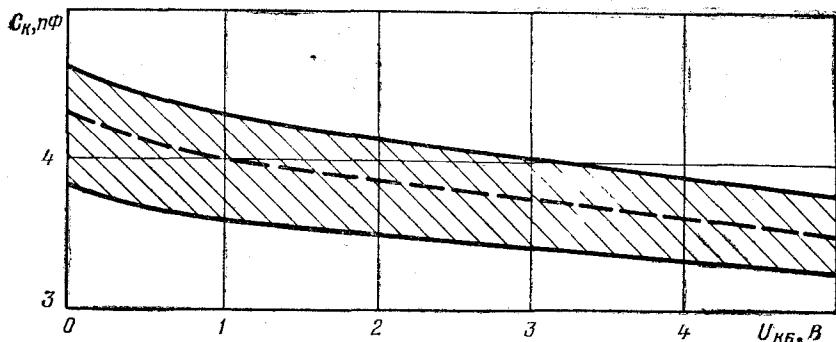
n-p-n

2T318A-1÷2T318B1-1

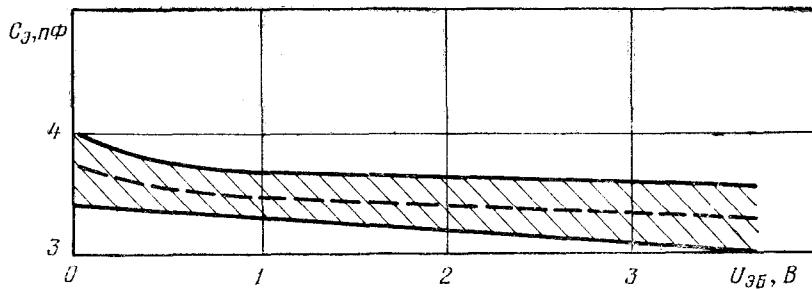
ОБЛАСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ЕМКОСТИ ЭМИТТЕРНОГО ПЕРЕХОДА
НА ЧАСТОТЕ 10 МГц В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАПРЯЖЕНИЯ
ЭМИТТЕР—БАЗА
(границы 95% разброса)



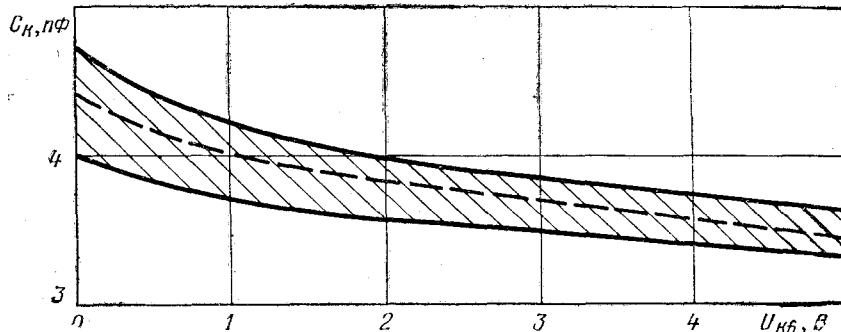
ОБЛАСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ЕМКОСТИ КОЛЛЕКТОРНОГО ПЕРЕХОДА
НА ЧАСТОТЕ 10 МГц В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАПРЯЖЕНИЯ
КОЛЛЕКТОР—БАЗА
(границы 95% разброса)



ОБЛАСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ЕМКОСТИ ЭМИТЕРНОГО ПЕРЕХОДА
НА ЧАСТОТЕ 10 МГц В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАПРЯЖЕНИЯ
ЭМИТЕР-БАЗА
(границы 95 % разброса)



ОБЛАСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ЕМКОСТИ КОЛЛЕКТОРНОГО ПЕРЕХОДА
НА ЧАСТОТЕ 10 МГц В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАПРЯЖЕНИЯ
КОЛЛЕКТОР-БАЗА
(границы 95 % разброса)



КРЕМНИЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ
п—р—п

2T318A-1÷2T318E-1

ОБЛАСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ НАИБОЛЬШЕГО НАПРЯЖЕНИЯ
КОЛЛЕКТОР—БАЗА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОПРОТИВЛЕНИЯ В ЦЕПИ
ЭМИТЕР—БАЗА
(границы 95% разброса)

